

2SC1741AM (3DG1741AM)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途：用于中功率放大。

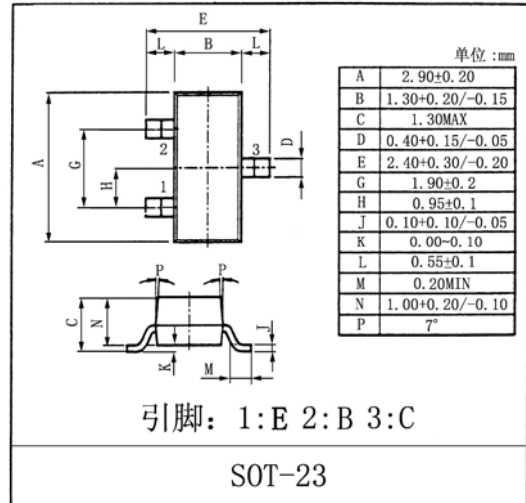
Purpose: Medium power transistor .

特点：集电极电流大, $V_{CE(sat)}$ 饱和压降低。

Features: High I_c , Low $V_{CE(sat)}$.

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^\circ C$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	50	V
V_{CE0}	50	V
V_{EB0}	5.0	V
I_c	0.5	A
P_c	0.3	W
T_j	150	$^\circ C$
T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^\circ C$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_c=100 \mu A$ $I_E=0$	50			V
V_{CE0}	$I_c=1.0mA$ $I_B=0$	50			V
V_{EB0}	$I_E=100 \mu A$ $I_c=0$	5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=30V$ $I_E=0$			0.5	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=4.0V$ $I_c=0$			0.5	μA
h_{FE}	$V_{CE}=3.0V$ $I_c=0.1A$	120		560	
$V_{CE(sat)}$	$I_c=150mA$ $I_B=15mA$			0.4	V
f_T	$V_{CE}=5.0V$ $I_E=-20mA$ $f=100MHz$		250		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		6.5		pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	Q	R
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	120~270	180~390
印章 Marking	H74Q	H74R

2SC1741AM (3DG1741AM)

